

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2022 년 11 월 24 일 (24.11.2022) WIPO | PCT



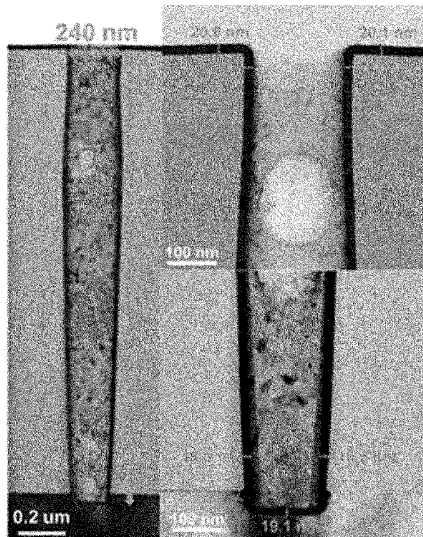
(10) 국제공개번호

WO 2022/245039 A1

- (51) 국제특허분류: C07F 7/00 (2006.01) C23C 16/455 (2006.01)
C23C 16/40 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2022/006709
- (22) 국제출원일: 2022 년 5 월 11 일 (11.05.2022)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보: 10-2021-0065659 2021 년 5 월 21 일 (21.05.2021) KR
- (71) 출원인: 주식회사 아이켄스 (ICHEMS CO., LTD.) [KR/KR]; 18374 경기도 화성시 반정로 204번길 73, Gyeonggi-do (KR).
- (72) 발명자: 김현창 (KIM, Hyun Chang); 18374 경기도 화성시 반정로 204번길 73, Gyeonggi-do (KR). 신형수 (SHIN, Hyung Soo); 18374 경기도 화성시 반정로 204번길 73, Gyeonggi-do (KR). 이두현 (LEE, Doo Hun); 18374 경기도 화성시 반정로 204번길 73, Gyeonggi-do (KR). 권철희 (KWON, Chul Hee); 18374 경기도 화성시 반정로 204번길 73, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 이병진 (LEE, Byong Jin); 30150 세종시 한누리대로 2149, 304호 (엔젤타워), Sejong (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: NOVEL HAFNIUM-CONTAINING COMPOUND, HAFNIUM PRECURSOR COMPOSITION CONTAINING SAME, HAFNIUM-CONTAINING THIN FILM USING HAFNIUM PRECURSOR COMPOSITION, AND PREPARATION METHOD THEREFOR

(54) 발명의 명칭: 신규한 하프늄 함유 화합물, 이를 함유하는 하프늄 전구체 조성물, 상기 하프늄 전구체 조성물을 이용한 하프늄 함유 박막 및 이의 제조방법.



(57) Abstract: The present invention relates to a hafnium-containing precursor that can be used in the formation of various hafnium-containing thin films, wherein the hafnium-containing precursor is liquid at room temperature and exhibits high volatility and high thermal stability and thus can be used in a high-quality hafnium-containing thin film and a preparation method therefor.

(57) 요약서: 본 발명은 다양한 하프늄 함유 박막의 형성에 사용될 수 있는 하프늄 함유 전구체에 관한 것으로 상기 하프늄 함유 전구체는 상온에서 액체이고 높은 휘발성과 높은 열적 안정성을 나타내므로 고품질의 하프늄 함유 박막 및 이의 제조방법에 사용될 수 있다.

WO 2022/245039 A1

[다음 쪽 계속]

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))